

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова  
Физический факультет  
Кафедра физической электроники

Павлов Александр Игоревич

Студент 214 группы

Курсовая работа на тему

«Собственные колебания ограниченной плазмы в магнитном поле»

Научный руководитель

доц. Двинин Сергей Александрович

Москва

2020

<b>Содержание</b>	<b>2</b>
<b>Введение.</b>	<b>2</b>
<b>1. Постановка задачи</b>	<b>4</b>
<b>2 Диэлектрическая проницаемость холодной плазмы в магнитном поле</b>	<b>4</b>
<b>3. Дисперсия волн, используемых для поддержания газового разряда в магнитном поле. Традиционный расчет. Уравнение четвертой степени</b>	<b>6</b>
<b>4. Дисперсия волн, используемых для поддержания газового разряда в магнитном поле, с учетом давления электронов</b>	<b>8</b>
<b>5. Расчет импеданса плазмы с помощью программы COMSOL Multiphysics®</b>	<b>12</b>
<b>Выводы</b>	<b>18</b>
<b>Благодарности</b>	<b>18</b>
<b>Приложение I. Расчет векторных полей по их вихрю и дивергенции.</b>	<b>18</b>
<b>Приложение II. Движение электрона в постоянном магнитном поле и в скрещенных электрическом и магнитном полях</b>	<b>19</b>
<b>Приложение III. Детали расчета токов в плазме и диэлектрической проницаемости с учетом давления электронного газа</b>	<b>20</b>
<b>Приложение IV. Расчет дисперсии волн в магнитном поле</b>	<b>20</b>
<b>Список литературы</b>	<b>24</b>

Одним из важнейших вопросов организации плазменных технологических процессов является разработка источников плазмы, обладающих свойствами, оптимальными для данной технологии, например: высокой однородностью, заданными плотностью плазмы, энергией заряженных частиц, концентрацией химически активных радикалов. Анализ показывает, что наиболее перспективными для применения в промышленных технологиях являются высокочастотные (ВЧ) источники плазмы, так как, во-первых, с их помощью можно обрабатывать как проводящие, так и диэлектрические материалы, а во-вторых, в качестве рабочих газов можно использовать не только инертные, но и химически активные газы. Сегодня известны источники плазмы, основанные на емкостном и индуктивном ВЧ-разрядах. Особенностью емкостного ВЧ-разряда, наиболее часто используемой в плазменных технологиях, является существование приэлектродных слоев объемного заряда, в которых формируется среднее по времени падение потенциала, ускоряющего ионы в направлении электрода. Это позволяет обрабатывать с помощью ускоренных ионов образцы материалов, расположенные на электродах ВЧ-емкостного разряда. Один из последних анализов применения разряда в магнитном поле и способов его возбуждения поведен в [1]. В дальнейшем мы во многом следуем этой работе.

Индуктивный ВЧ-разряд без магнитного поля известен уже более ста лет [2, 3]. Это разряд, возбуждаемый током, текущим по индуктору, расположенному на боковой или торцевой поверхности, как правило, цилиндрического источника плазмы. Еще в 1891 г. Дж.Дж. Томсон высказал предположение [2] о том, что индуктивный разряд вызывается и поддерживается вихревым электрическим полем, которое создается магнитным полем, в свою очередь, индуцируемым током, текущим по антенне. В 1928-1929 гг., полемизируя с Дж.Дж. Томсоном, Д. Таунсенд и Р. Дональдсон [4, 5] высказали идею о том, что индуктивный ВЧ-

разряд поддерживается не вихревыми электрическими полями, а потенциальными, появляющимися благодаря наличию разности потенциалов между витками индуктора. В 1929 г. К. Мак-Кинтон [6] экспериментально показал возможность существования двух режимов горения разряда.

В настоящее время известны источники плазмы низкого давления, принцип действия которых основан на индуктивном ВЧ-разряде в отсутствие магнитного поля, а также на индуктивном ВЧ-разряде, помещенном во внешнее магнитное поле с индукцией, соответствующей условиям электронного циклотронного резонанса (ЭЦР) и условиям возбуждения геликонов и волн Трайвелписа - Голда (ТГ) (далее называемых геликонными источниками).

Типичными примерами источников плазмы, работающих на индуктивном ВЧ-разряде без магнитного поля, являются плазменные реакторы, предназначенные для травления подложек [7], источники ионов, предназначенные для реализации земных ионно-пучковых технологий и работы в космосе в качестве двигателей коррекции орбиты космических аппаратов [8], источники света [9]. Общей конструктивной особенностью перечисленных устройств является наличие газоразрядной камеры (ГРК), на внешней поверхности которой или внутри ее расположен индуктор или антенна. С помощью антенны, подключенной к высокочастотному генератору, в объем ГРК вводится ВЧ-мощность и зажигается безэлектродный разряд. Токи, текущие по антенне, индуцируют в плазме вихревое электрическое поле, которое нагревает электроны до энергий, необходимых для эффективной ионизации рабочего газа. Типичные плотности плазмы в плазменных реакторах составляют величину  $10^{11} - 3 \times 10^{12} \text{ см}^{-3}$ , а в источниках ионов —  $3 \times 10^{10} - 3 \times 10^{11} \text{ см}^{-3}$ . Характерное давление нейтрального газа в плазменных реакторах изменяется от 1 до 30 мТор, в источниках ионов составляет величину 0,1 мТор, в источниках света — 0,1-10 Тор.

Известно, что в плазме индуктивного разряда ВЧ- электрические поля скинируются, т.е. нагрев электронов осуществляется в узком пристеночном слое. При приложении к плазме индуктивного ВЧ-разряда внешнего магнитного поля появляются области прозрачности, в которых ВЧ-поля проникают вглубь плазмы и нагрев электронов осуществляется во всем ее объеме. Этот эффект использован в источниках плазмы, принцип действия которых основан на ЭЦР. Такие источники работают главным образом в микроволновом диапазоне (2,45 ГГц) [10]. Микроволновое излучение вводится, как правило, через кварцевое окно в цилиндрическую газоразрядную камеру, в которой с помощью магнитов формируется неоднородное магнитное поле. Магнитное поле характеризуется наличием одной или нескольких резонансных зон, в которых выполняются условия ЭЦР и происходит ввод ВЧ-мощности в плазму. Другим типом источников, использующих индуктивный ВЧ-разряд с внешним магнитным полем, являются геликонные источники плазмы [11, 12], обычно состоящие из двух полых цилиндров, изготовленных из диэлектрического материала. На внешней боковой поверхности цилиндра меньшего диаметра устанавливается антенна, форма которой оптимальна для возбуждения геликонов и ТГ-волн. Волны проходят в камеру с большим диаметром вдоль аксиального магнитного поля, создаваемого магнитной системой. Типичная концентрация плазмы в геликонных источниках достигает  $10^{12} \text{ см}^{-3}$ , магнитное поле составляет величину порядка 500 -1000 Гс, ВЧ-мощность — 2-3 кВт.

В работах [13, 14] представлены плазменный реактор и источник ионов, работающие при условиях, когда геликон является поверхностной волной, а ТГ-волна проникает вглубь плазмы. Источник ионов [14] позволяет получать плотность ионного тока от 0,5 до 3 мА см<sup>2</sup> при уровне ВЧ-мощности, не превышающем 150 Вт. Магнитное поле составляет величину 200-300 Гс.

Обобщим приведенные выше параметры плазмы, типичные для индуктивных источников плазмы. Как правило, радиус ВЧ-источников плазмы составляет 2 – 25 см, длина  $L$  – от 3 до 50 см. Диапазон изменения плотности плазмы  $n_e \sim 10^{10} - 3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$  при температуре электронов  $T_e \sim 3 - 8 \text{ эВ}$  ( $3 \cdot 10^4 - 9 \cdot 10^4 \text{ К}$ ). Давление нейтрального газа  $p$  в источниках (за исключением источников света) изменяется от 0,1 до 10 мТор. Величина магнитного поля изменяется от 0 до 1 кГс. В настоящей статье свойства индуктивного ВЧ-разряда проанализированы в пределах указанных диапазонов параметров плазмы. Несмотря на большое число схем плазменных устройств, работающих на индуктивном ВЧ-разряде, постоянно возрастающие и изменяющиеся требования плазменных технологий требуют усовершенствования моделей старых устройств и разработки новых перспективных моделей.

## 1. Постановка задачи

Как видно из проведенного обзора литературы, развитие плазменных технологий ставит перед разработчиками источников плазмы целый ряд вопросов. Как правило, при решении электродинамической задачи в магнитном поле ограничиваются предположением о возбуждении одной электродинамической моды. Кроме того жестко не фиксируются граничные условия для электромагнитного поля, что не позволяет описать возможный переход от одной электромагнитной моды поля поддерживающей разряд к другой. Поэтому при написании данной курсовой работы была поставлена следующая задача.

1. Изучить типы волн, которые могут быть использованы для поддержания плазмы в магнитном поле.
2. Рассчитать дисперсию этих волн и проанализировать какие из них могут быть использованы для возбуждения плазмы разряда.
3. Используя существующие в научной группе программы расчета импеданса разряда с помощью пакета программ COMSOL Multiphysics® провести предварительный расчет импеданса разряда в постоянном однородном и пространственном распределении электромагнитного поля в разряде.

## 2. Уравнения Максвелла. Диэлектрическая проницаемость холодной плазмы в магнитном поле

Для описания пространственного распределения электромагнитного поля в плазме необходимо решать уравнения Максвелла [15 – 18]. Для синусоидальных полей с частотой  $\omega$

$$\begin{pmatrix} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) \\ \hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ \mathbf{H}(\mathbf{r}) \end{pmatrix} \exp(-i\omega t), \quad (1)$$

они могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned} [\nabla \times \mathbf{H}] + ik_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \varepsilon \mathbf{E} = \mathbf{j}(\mathbf{E}), \quad [\nabla \times \mathbf{E}] - ik_0 \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \mathbf{H} = 0, \quad (\nabla \cdot \mathbf{H}) = 0, \\ (\nabla \cdot \mathbf{E}) = \rho / \varepsilon_0. \end{aligned} \quad (2)$$

При записи уравнений использованы соотношения  $\mathbf{r}$ ,  $t$  – время и координата,  $k_0 = \omega/c$ ,  $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$  – скорость света,  $\varepsilon_0$ ,  $\mu_0$  – диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума,  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$  – электрическое и магнитное поля,  $\mathbf{j}$  – ток электронов в плазме,  $\rho$  – пространственный заряд электронов. Мы рассматриваем достаточно высокие частоты электромагнитного поля, при которых движением ионов можно пренебречь. В (1) система уравнений Максвелла записана в системе СИ. В системе СГС эта система будет иметь вид

$$[\nabla \times \mathbf{H}] + i \frac{\omega}{c} \mathbf{E} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{E}), \quad [\nabla \times \mathbf{E}] - i \frac{\omega}{c} \mathbf{H} = 0, \quad (\nabla \cdot \mathbf{H}) = 0, \quad (\nabla \cdot \mathbf{E}) = 4\pi\rho.$$

Для того, чтобы рассчитать пространственные распределения электромагнитного поля, необходимо рассчитать токи электронов и их пространственный заряд, которые возникнут под воздействием электрического поля. В простейшем случае для их расчета используют уравнения гидродинамики

$$\frac{\partial \mathbf{V}_e}{\partial t} + (\mathbf{V}_e \nabla) \mathbf{V}_e = -\frac{\gamma k T_e}{m} \frac{\nabla n_e}{n_e} - \frac{e}{m} \left\{ \mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{V}_e \times (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B})] \right\} - \nu_{en} \mathbf{V}_e, \quad (3)$$

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + (\nabla \cdot n_e \mathbf{V}_e) = 0.$$

Введем обозначения:  $e$ ,  $m$  – заряд и масса электрона,  $n_e$ ,  $T_e$ ,  $\mathbf{V}_e$  – плотность, температура и скорость электронов,  $\Omega_+ = e\mathbf{B}/mc$  – их циклотронная частота.

Ограничимся линейным приближением по электромагнитному полю и будем искать решение в виде синусоидальных волн

$$\mathbf{V}_e = \mathbf{V}_0 \exp(-i\omega t + i\mathbf{k}\mathbf{r}), \quad \mathbf{E}_e = \mathbf{E}_0 \exp(-i\omega t + i\mathbf{k}\mathbf{r}), \quad n_e = n_0 + \delta n_e \exp(-i\omega t + i\mathbf{k}\mathbf{r}).$$

Получим систему уравнений, в которой предполагается, что постоянное магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$  и введены обозначения  $C_S^2 = \gamma k T_e / m$ ,  $\gamma = c_p / c_v$  – показатель адиабаты,  $c_p$ ,  $c_v$  – теплоемкости электронного газа при постоянном давлении и постоянном объеме

$$-i\omega \mathbf{V}_e = -i\mathbf{k} C_S^2 \frac{\delta n_e}{n_0} - \frac{e}{m} \left\{ \mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{V} \times \mathbf{B}_0] \right\} - \nu_{en} \mathbf{V}_e, \quad \frac{\delta n_e}{n_0} = \frac{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e)}{i\omega}. \quad (4)$$

Подставим в левое уравнение наше выражение для плотности электронов

$$(-i\omega + \nu_{en}) \mathbf{V}_e + i\mathbf{k} C_S^2 \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e)}{\omega} + \frac{e}{mc} [\mathbf{V} \times \mathbf{B}_0] = -\frac{e}{m} \mathbf{E}. \quad (5)$$

Или

$$-i\omega \mathbf{V}_e = -i\mathbf{k} C_S^2 \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e)}{\omega} - \frac{e}{m} \left\{ \mathbf{E} + \frac{1}{c} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \mathbf{V}_x & \mathbf{V}_y & \mathbf{V}_z \\ 0 & 0 & \mathbf{B}_0 \end{bmatrix} \right\} - \nu_{en} \mathbf{V}_e$$

Решение этой системы уравнений (см. приложение I) дает возможность рассчитать скорости электронов, их ток и возмущения их плотности.

$$\begin{pmatrix} (\omega(\omega + i\nu_{en}) - C_S^2 k_x^2) & (-i\Omega_e \omega - C_S^2 k_x k_y) & -C_S^2 k_x k_z \\ (i\omega \Omega_e - C_S^2 k_x k_y) & (\omega(\omega + i\nu_{en}) - C_S^2 k_y^2) & -C_S^2 k_y k_z \\ -C_S^2 k_x k_z & -C_S^2 k_y k_z & (\omega(\omega + i\nu_{en}) - C_S^2 k_z^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{V}_x \\ \mathbf{V}_y \\ \mathbf{V}_z \end{pmatrix} = -\frac{ie\omega}{m} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_x \\ \mathbf{E}_y \\ \mathbf{E}_z \end{pmatrix} \quad (5A)$$

Здесь  $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$  Очень часто рассматривается распространение волны под углом  $\theta$  – к оси  $OZ$ . В этом случае  $\mathbf{k} = (k \sin \theta, 0, k \cos \theta)$ . Отметим, что при анализе собственных волн в волноведущих структурах вектор  $\mathbf{k}$  может иметь не только действительную, но и комплексную компоненту.

Умножая (5) на плотность и заряд электронов получим

$$\begin{pmatrix} \mathbf{j}_x \\ \mathbf{j}_y \\ \mathbf{j}_z \end{pmatrix} = -\frac{ine^2\omega}{m} \begin{pmatrix} (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_x^2) & (-i\Omega_e \omega - C_S^2 k_x k_y) & -C_S^2 k_x k_z \\ (i\omega\Omega_e - C_S^2 k_x k_y) & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_y^2) & -C_S^2 k_y k_z \\ -C_S^2 k_x k_z & -C_S^2 k_y k_z & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_z^2) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_x \\ \mathbf{E}_y \\ \mathbf{E}_z \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Фактически в (5) мы получили выражение для тензора проводимости плазмы

$$(\hat{\sigma}) = -\frac{ine^2\omega}{m} \begin{pmatrix} (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_x^2) & (-i\Omega_e \omega - C_S^2 k_x k_y) & -C_S^2 k_x k_z \\ (i\omega\Omega_e - C_S^2 k_x k_y) & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_y^2) & -C_S^2 k_y k_z \\ -C_S^2 k_x k_z & -C_S^2 k_y k_z & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_z^2) \end{pmatrix}^{-1},$$

А также для диэлектрической проницаемости плазмы

$$(\hat{\epsilon}_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{4\pi ne^2}{m} \begin{pmatrix} (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_x^2) & (-i\Omega_e \omega - C_S^2 k_x k_y) & -C_S^2 k_x k_z \\ (i\omega\Omega_e - C_S^2 k_x k_y) & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_y^2) & -C_S^2 k_y k_z \\ -C_S^2 k_x k_z & -C_S^2 k_y k_z & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_z^2) \end{pmatrix}^{-1}.$$

Хотя в полученной формуле мы учли давление электронного газа, мы не учли конечность Ларморовского радиуса электронов, поэтому наше выражение справедливо только на масштабах больших по сравнению с ларморовским радиусом электронов. В противном случае нужно использовать более точные выражения [17, 18]. В литературе обычно используется диэлектрическая проницаемость холодной плазмы, в которой давление электронов не учитывается и  $C_S=0$ . В этом случае рассматриваемая матрица легко обращается и мы получаем хорошо известное выражение для диэлектрической проницаемости [19]  $\omega_{Pe}^2 = 4\pi ne^2/m$ :

$$(\hat{\epsilon}_{ij}) = \begin{pmatrix} \epsilon_{\perp} & ig & 0 \\ -ig & \epsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{\parallel} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{(\omega + iv_{en})\omega_{Pe}^2}{\omega((\omega + iv_{en})^2 - \Omega_e^2)} & \frac{i\Omega_e \omega_{Pe}^2}{\omega((\omega + iv_{en})^2 - \Omega_e^2)} & 0 \\ \frac{-i\Omega_e \omega_{Pe}^2}{\omega((\omega + iv_{en})^2 - \Omega_e^2)} & 1 - \frac{(\omega + iv_{en})\omega_{Pe}^2}{\omega((\omega + iv_{en})^2 - \Omega_e^2)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\omega_{Pe}^2}{\omega(\omega + iv_{en})} \end{pmatrix}.$$

### 3. Дисперсия волн, используемых для поддержания газового разряда в магнитном поле. Традиционный расчет. Уравнение четвертой степени

Полученные в предыдущем параграфе выражения для тока в плазме совместно с уравнениями максвелла позволяет получить уравнения, описывающие дисперсию (связь постоянной распространения и частоты волны). Простейший путь заключается в использовании стандартного подхода холодной плазмы и полученного в предыдущем параграфе выражения для диэлектрической проницаемости. Из уравнений Максвелла следует

$$[\nabla \times [\nabla \times \mathbf{E}]] - \frac{\omega^2}{c^2} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{E} = 0.$$

При учете пространственной зависимости в виде  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$  уравнение принимает вид.

$$[\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \mathbf{E}]] + \frac{\omega^2}{c^2} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{E} = 0$$

В векторном виде это уравнение будет

$$\begin{pmatrix} k_y^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} & k_x k_y + i \frac{\omega^2}{c^2} g & k_x k_z \\ k_x k_y - i \frac{\omega^2}{c^2} g & k_x^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} & k_y k_z \\ k_x k_z & k_y k_z & k_x^2 + k_y^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = 0$$

Постоянная распространения электромагнитной волны как функция частоты, или частота, как функция постоянной распространения, может быть получена как решение дисперсионного уравнения, представляющее собой определитель системы этой системы уравнений

$$\begin{vmatrix} k_y^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} & k_x k_y + i \frac{\omega^2}{c^2} g & k_x k_z \\ k_x k_y - i \frac{\omega^2}{c^2} g & k_x^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} & k_y k_z \\ k_x k_z & k_y k_z & k_x^2 + k_y^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\parallel} \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрытие определителя приводит в так называемому уравнению четвертой степени.

$$\begin{aligned} & \left( k_y^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) \left( k_x^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) \left( k_x^2 + k_y^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\parallel} \right) - \left( k_y^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) k_y^2 k_z^2 + \\ & + \left( k_x k_y + i \frac{\omega^2}{c^2} g \right) k_y k_x k_z^2 - \left( k_x^2 k_y^2 + \frac{\omega^4}{c^4} g^2 \right) \left( k_x^2 + k_y^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\parallel} \right) + \\ & + \left( k_x k_y - i \frac{\omega^2}{c^2} g \right) k_x k_y k_z^2 - \left( k_x^2 + k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) k_x^2 k_z^2 = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Запишем это уравнение в нескольких формах удобных для вычисления  $h = k_z$ ,

$$k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2:$$

$$\frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} h^4 - \left\{ \frac{2\omega^2 \varepsilon_{\parallel}}{c^2} - \left\{ \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} + 1 \right\} k_{\perp}^2 \right\} h^2 + \left\{ \frac{\omega^4 \varepsilon_{\parallel}}{c^4} \left\{ \varepsilon_{\perp} - \frac{g^2}{\varepsilon_{\perp}} \right\} - \left\{ \frac{\omega^2 \varepsilon_{\parallel}}{c^2} + \frac{\omega^2 \varepsilon_{\perp}}{c^2} - \frac{\omega^2 g^2}{c^2 \varepsilon_{\perp}} \right\} k_{\perp}^2 + k_{\perp}^4 \right\} = 0 \quad (8)$$

или

$$\frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} h^4 - \left\{ \frac{2\omega^2 \varepsilon_{\parallel}}{c^2} - \left\{ \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} + 1 \right\} k_{\perp}^2 \right\} h^2 + \left\{ k_{\perp}^2 - \frac{\omega^2 \varepsilon_{\parallel}}{c^2} \right\} \left\{ k_{\perp}^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \left\{ \varepsilon_{\perp} - \frac{g^2}{\varepsilon_{\perp}} \right\} \right\} = 0$$

Для величины  $k$ :

$$k_{\perp}^4 - \left\{ \frac{\omega^2 \varepsilon_{\parallel}}{c^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \left\{ \varepsilon_{\perp} - \frac{g^2}{\varepsilon_{\perp}} \right\} - \left\{ \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} + 1 \right\} h^2 \right\} k_{\perp}^2 + \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} \left\{ \left\{ \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} - h^2 \right\}^2 - \frac{\omega^4}{c^4} g^2 \right\} = 0$$

Для частоты:

$$\frac{\omega^4}{c^4} \varepsilon_{\parallel} \left( \varepsilon_{\perp} - \frac{g^2}{\varepsilon_{\perp}} \right) - \frac{\omega^2}{c^2} \left( 2\varepsilon_{\parallel} h^2 + k_{\perp}^2 \left( \varepsilon_{\parallel} + \varepsilon_{\perp} - \frac{g^2}{\varepsilon_{\perp}} \right) \right) + \left( \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} h^4 + \left( \frac{\varepsilon_{\parallel}}{\varepsilon_{\perp}} + 1 \right) h^2 k_{\perp}^2 + k_{\perp}^4 \right) = 0.$$

## 5. Дисперсия волн, используемых для поддержания газового разряда в магнитном поле с учетом давления электронов

Второй подход состоит в использовании общих решений уравнений гидродинамики с подстановкой в них решений уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Выделим в электрическом поле две компоненты – потенциальное и вихревое поля. В соответствии с уравнениями Максвелла получим ( $e > 0$ ):

$$\mathbf{E} = -\frac{c}{i\omega} [\nabla \times \mathbf{H}] + \frac{4\pi}{i\omega} \mathbf{j} = -\frac{c}{i\omega} [\nabla \times \mathbf{H}] - \frac{4\pi n_0 e}{i\omega} \mathbf{V} = -\frac{c}{\omega} [\mathbf{k} \times \mathbf{H}] - \frac{4\pi n_0 e}{i\omega} \mathbf{V},$$

$$\mathbf{H} = \frac{c}{i\omega} [\nabla \times \mathbf{E}] = \frac{c}{\omega} [\mathbf{k} \times \mathbf{E}], \quad (\mathbf{k} \cdot \mathbf{H}) = 0, \quad (i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) = -4\pi \delta n_e e = -\frac{4\pi n_0 e}{i\omega} (i\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e).$$

Отсюда

$$\mathbf{E} + \frac{c^2}{\omega^2} [\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \mathbf{E}]] = -\frac{4\pi n_0 e}{i\omega} \mathbf{V}_e$$

Как обычно, это уравнение мы можем решить только учитывая, что  $[\nabla \times [\nabla \times \mathbf{E}]] = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ . Тогда

$$\left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \mathbf{E} = -\frac{4\pi n_0 e}{i\omega} \mathbf{V}_e - \frac{c^2 \mathbf{k}}{\omega^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})$$

То есть решить его, не выделяя продольные и поперечные поля нельзя. Тогда умножая наше уравнение скалярно на  $\mathbf{k}$  (или используя уравнение для дивергенции  $\mathbf{E}$ ) получим

$$(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) = -\frac{4\pi n_0 e}{i\omega} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e), \quad \mathbf{E} = -\frac{4\pi n_0 e}{i\omega} \left( \mathbf{V}_e - \frac{c^2 \mathbf{k}}{\omega^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) \right) / \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right)$$

Подставим эти выражения в полученные уравнения для скорости частиц (5), вводя обозначения  $\mathbf{\Omega}_0 = e\mathbf{B}_0/mc$ ,  $\omega_{pe}^2 = 4\pi n_0 e^2/m$

$$i\omega \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \left( (-i\omega + \nu_{en}) \mathbf{V}_e + i\mathbf{k} C_s^2 \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e)}{\omega} + [\mathbf{V} \times \mathbf{\Omega}_0] \right) - \omega_{pe}^2 \left( \mathbf{V}_e - \frac{c^2 \mathbf{k}}{\omega^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) \right) = 0. \quad (9)$$

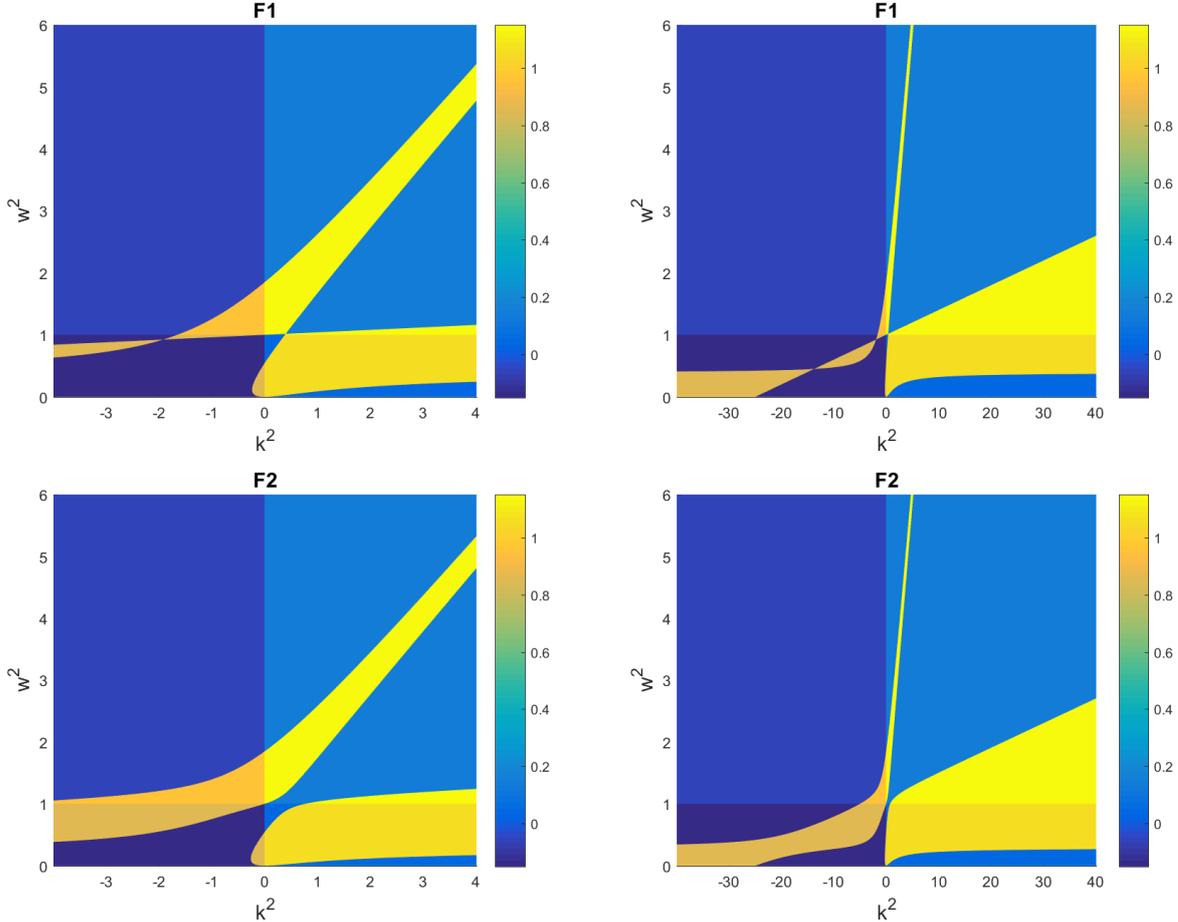
В матричном виде:

$$\begin{aligned}
\left(1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2}\right) & \begin{pmatrix} (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_x^2) & (-i\Omega_e \omega - C_S^2 k_x k_y) & -C_S^2 k_x k_z \\ (i\omega\Omega_e - C_S^2 k_x k_y) & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_y^2) & -C_S^2 k_y k_z \\ -C_S^2 k_x k_z & -C_S^2 k_y k_z & (\omega(\omega + iv_{en}) - C_S^2 k_z^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_0 V_x \\ \mathbf{y}_0 V_y \\ \mathbf{z}_0 V_z \end{pmatrix} = \\
& = \omega_{pe}^2 \left( \begin{pmatrix} \mathbf{x}_0 V_x \\ \mathbf{y}_0 V_y \\ \mathbf{z}_0 V_z \end{pmatrix} - \frac{c^2}{\omega^2} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_0 k_x \\ \mathbf{y}_0 k_y \\ \mathbf{z}_0 k_z \end{pmatrix} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}) \right)
\end{aligned} \quad (9A)$$

Мы получили систему уравнений для скорости электронов, определитель которой есть дисперсионное уравнение, которое в отличие от предыдущего будет учитывать и тепловое движение частиц. Решение уравнения приведено в Приложении IV.

Результаты расчета дисперсии волн приведены на рисунках ниже. На рисунке 1 выполнены условия  $\omega_{Le} > \Omega_0$  (плазменная частота  $\omega_{Le}$  больше циклотронной  $\Omega_0$ ), на рисунке 2  $\Omega_0 > \omega_{Le}$ , на рисунке 3  $\Omega_0 = 0$ . На рисунках используются безразмерные переменные. Ось частот нормирована на квадрат максимальной из частот  $\omega_{Le}$ ,  $\Omega_0$   $\tilde{\Omega}^2 = \text{Max}(\Omega_0^2, \omega_{Le}^2)$ , то есть  $w^2 = \omega^2 / \tilde{\Omega}^2$ . Квадрат волнового числа нормирован на  $\tilde{\Omega}^2 / c^2$ , то есть  $K^2 = k^2 c^2 / \tilde{\Omega}^2$ .

На графиках приведены расчеты: Сверху вниз 1 – распространение вдоль магнитного поля, 2. – под углом  $30^\circ$ , 3 – под углом  $60^\circ$ , 4 – перпендикулярно магнитному поля. В соответствии с формулами предыдущего параграфа  $(k_x, k_y, k_z) = (k \sin \theta, 0, k \cos \theta)$ . Дисперсионные кривые различных волн лежат на линиях контакта областей с различным зветом.



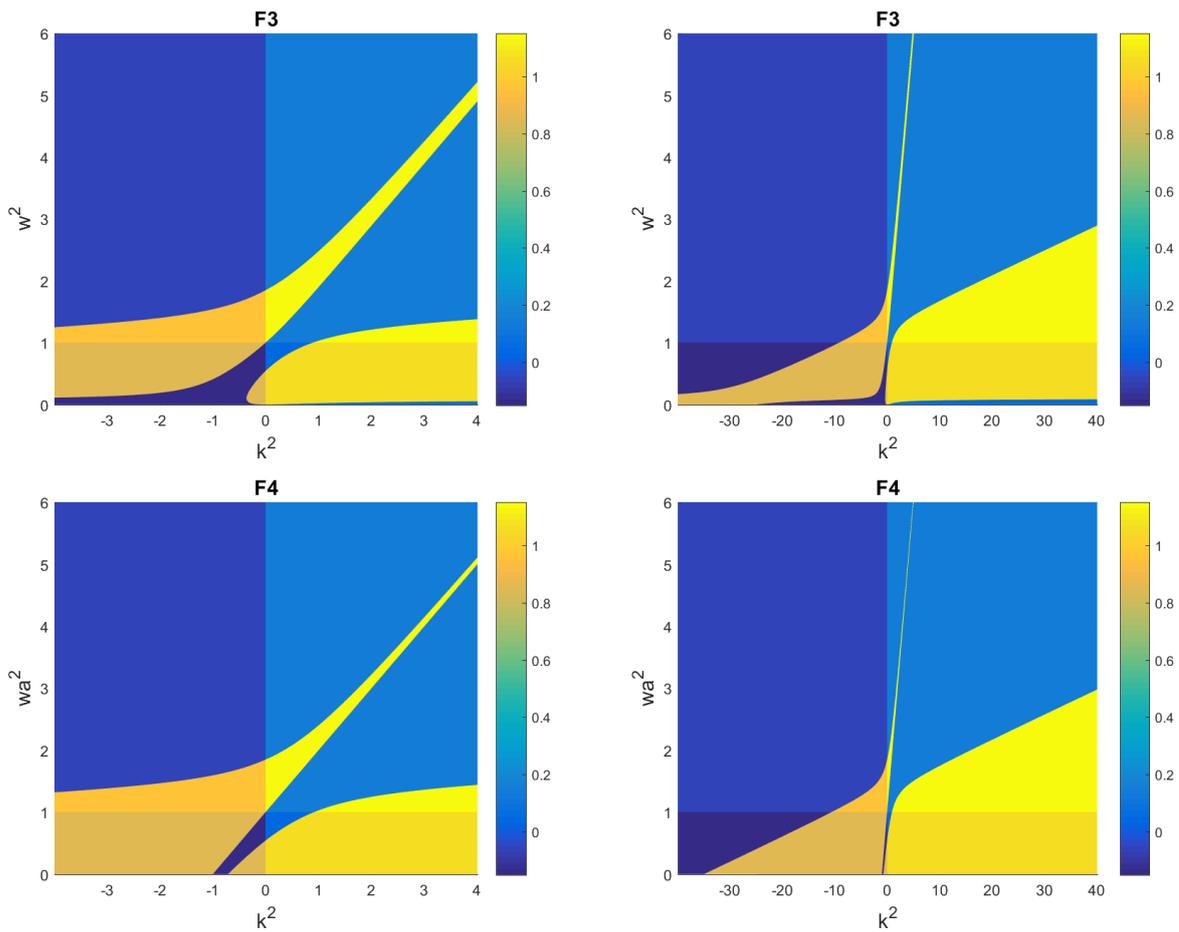
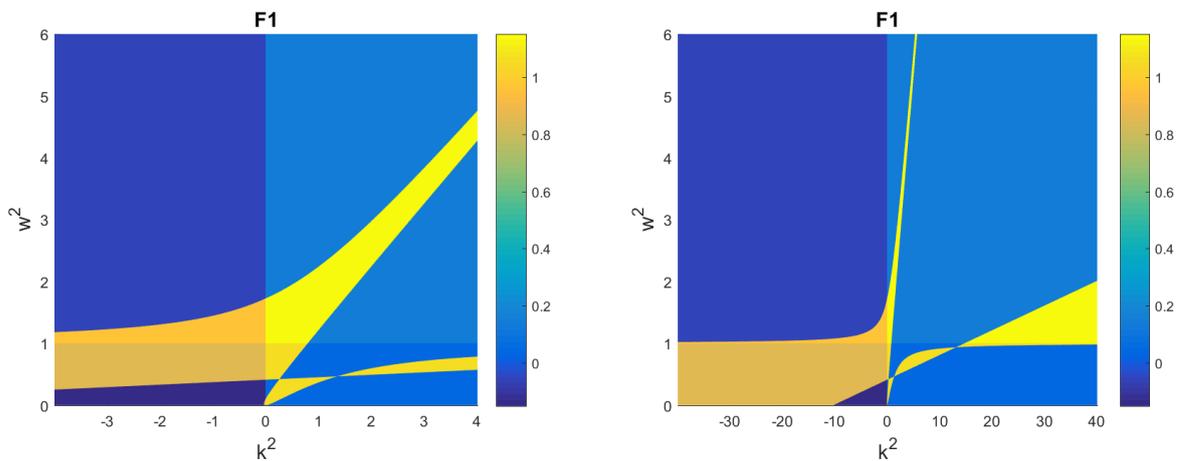


Рис. 1. Дисперсия волн в магнитном поле в зависимости от угла распространения. 1 – распространение вдоль магнитного поля, 2 – под углом  $30^\circ$ , 3 – под углом  $60^\circ$ , 4 – перпендикулярно магнитному полю.  $\omega_{pe}=5.6 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$ ,  $\Omega_e=3.5 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$ ,  $V_S/c=0.2$ . Можно выделить области распространения циркулярно-поляризованных поперечных волн, геликона, ленгмюровских (верхнегибридных) волн, скин-эффекта и дебаевского экранирования. Рисунки слева и справа отличаются масштабом по оси  $OZ$ .



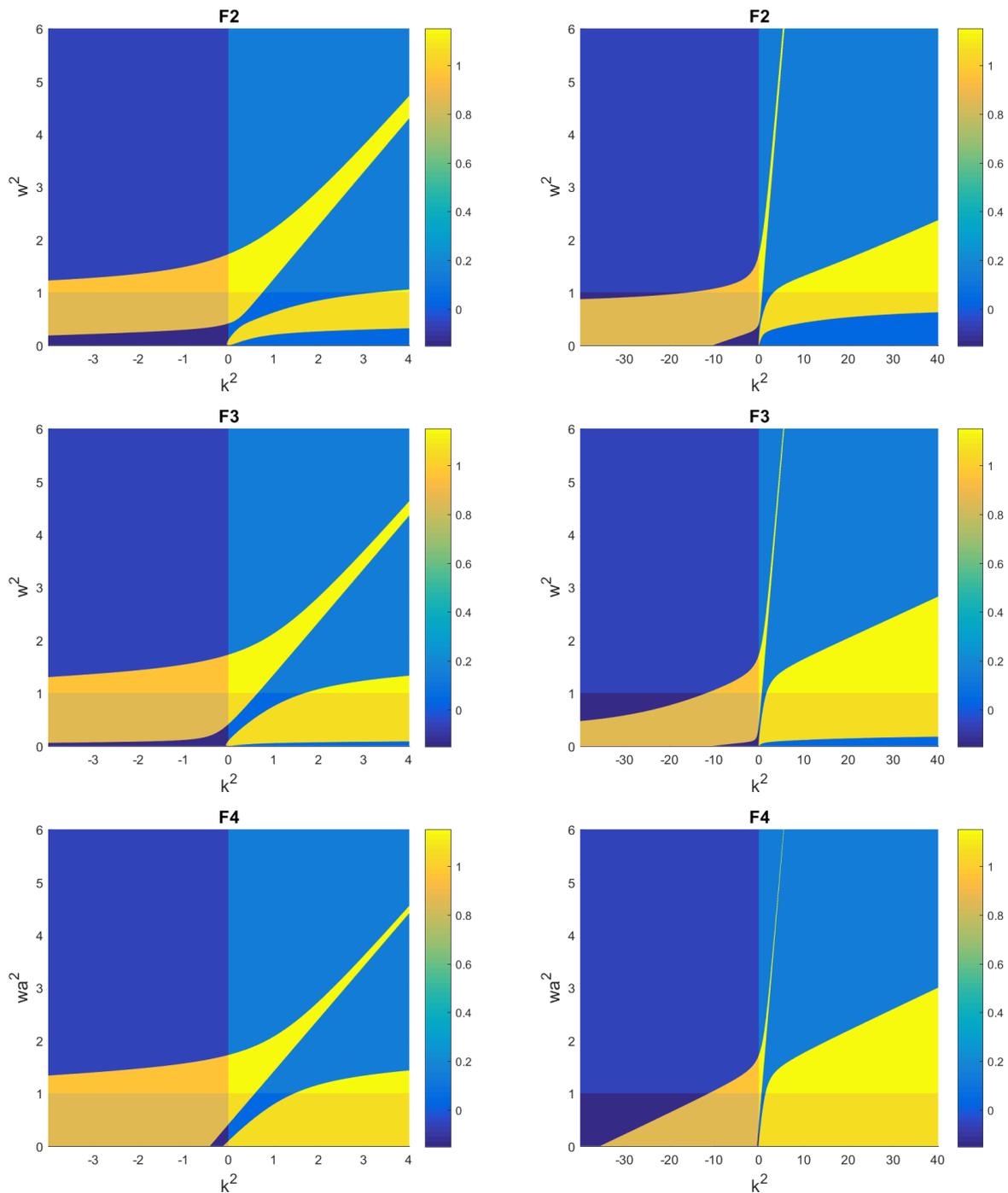


Рис. 2. Дисперсия волн в магнитном поле в зависимости от угла распространения. 1 – распространение вдоль магнитного поля, 2. – под углом  $30^\circ$ , 3 – под углом  $60^\circ$ , 4 – перпендикулярно магнитному поля.  $\omega_{pe}=5.6 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$ ,  $\Omega_e=8.8 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$ ,  $V_s/c=0.2$ . Можно выделить области распространения циркулярно-поляризованных поперечных волн, геликона, ленгмюровских (верхнегибридных) волн, скин-эффекта и дебаевского экранирования. Рисунки слева и справа отличаются масштабом по оси  $OZ$ .

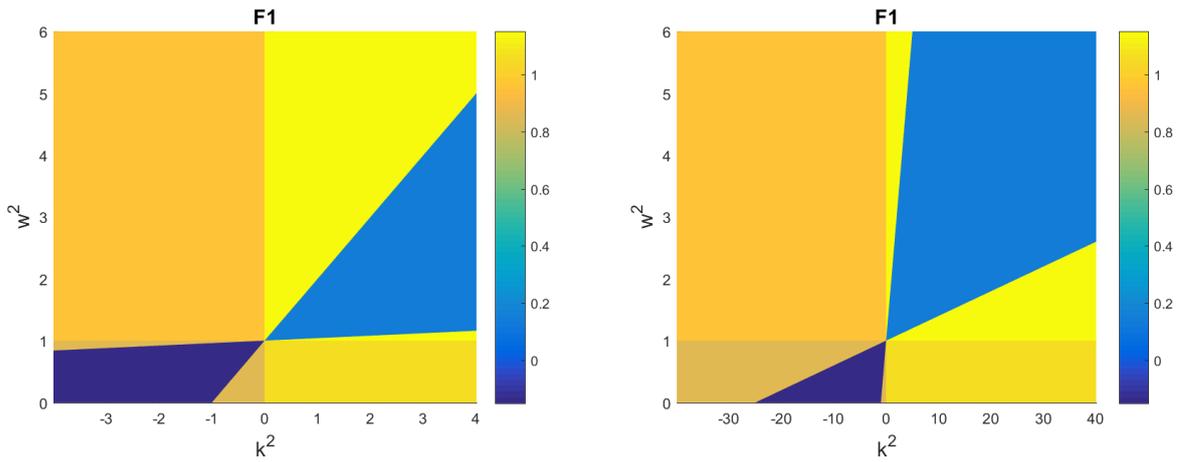


Рис. 3. Дисперсия волн в отсутствие магнитного поля.  $\omega_{pe}=5.6 \cdot 10^9 \text{ c}^{-1}$ ,  $\Omega_e=0 \text{ c}^{-1}$ ,  $V_S/c=0.2$ . Можно выделить ленгмюровскую волну, поперечную волну, область скин эффекта и область дебаевского экранирования.

#### 4. Расчет импеданса плазмы с помощью программы COMSOL Multiphysics®

Расчет импеданса разряда проводился с помощью пакета программ COMSOL Multiphysics® лицензия на которую принадлежит физическому факультету МГУ. Уравнения Максвелла решались в области пространства, включающей центральную часть камеры ( $0 < r < R_3$ ,  $-L < z < L$ ) и межэлектродное пространство, ( $R_1 < r < R_2$ ,  $-L < |z| < L + L_2$ ), **рис. 4**. На электродах и стенке вакуумной камеры ставились нулевые граничные условия для тангенциальной компоненты электрического поля. Рассматривался разряд с симметричным возбуждением, для которого ток  $I$ , втекающий через нижний электрод равен току, вытекающему через верхний. На внешней границе б ( $R_1 < r < R_2$ ,  $-|z|=L + L_2$ ) азимутальное магнитное поле считалось заданным  $H_\varphi(r, \pm(L + L_2)) = I/2\pi r$ .

Импеданс рассчитывался в нескольких точках. Во-первых, на границе разряда ( $r=R$ ), в этом случае в соответствии с общими формулами

$$I(R) = \frac{2\pi R}{L} \int_0^L H_\varphi(R, z) dz, \quad U = - \int_0^L E_z(R, z) dz, \quad Z = U/I.$$

При этом предполагалось, что ток определяется усредненным по высоте значением магнитного поля.

Во-вторых, на границе б расчетной области, формулы для импеданса в данном случае получим:

$$I = 2\pi R_1 H_\varphi(R_1, \pm L + L_2) = 2\pi R_2 H_\varphi(R_2, \pm L + L_2), \quad U = \int_{R_1}^{R_2} E_r(r, \pm(L + L_2)) dr, \quad Z = U/I$$

Импеданс рассчитывался в нескольких точках – на границе разряда (1,  $r=R$ , **рис. 5**), а также в подводящей к разрядной камере линии на расстоянии  $L_2=1 \text{ см}$  (2, **рис. 6**) и  $L_2=10 \text{ см}$  (3, в статье не приводятся) от разрядной камеры. Распределение плотности электронов в плазме при расчетах было однородно, а диэлектрическая проницаемость была задана в модели холодной плазмы. Со стороны внешней стенки ограничен диэлектриком с  $\epsilon=1$ .

Расчет проводился для симметричного (**рис. 5 – 8**) и антисимметричного (ток

генераторов течет на боковую стенку) возбуждения разряда (рис. 9 –10).

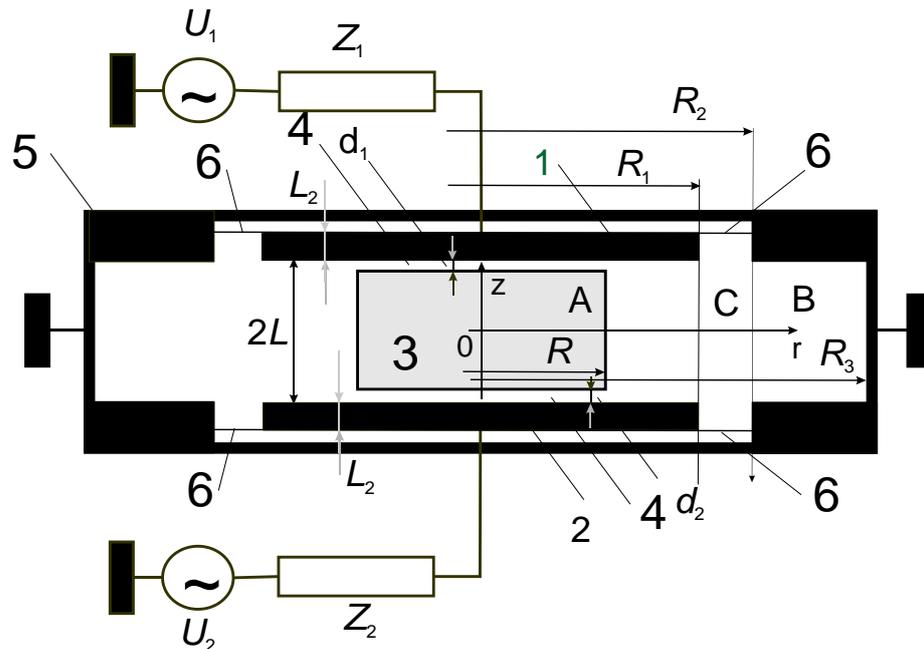


Рис. 4. Типичная схема экспериментальной установки 1, 2 – электроды, 3 – плазма, 4 – слои пространственного заряда между плазмой и стенкой (электродами), 5 – разрядная камера, 6 – граница расчетной области, через которую идет возбуждение электромагнитного поля.  $2L$  – межэлектродное расстояние,  $d_1, d_2$  – толщины слоев пространственного заряда.

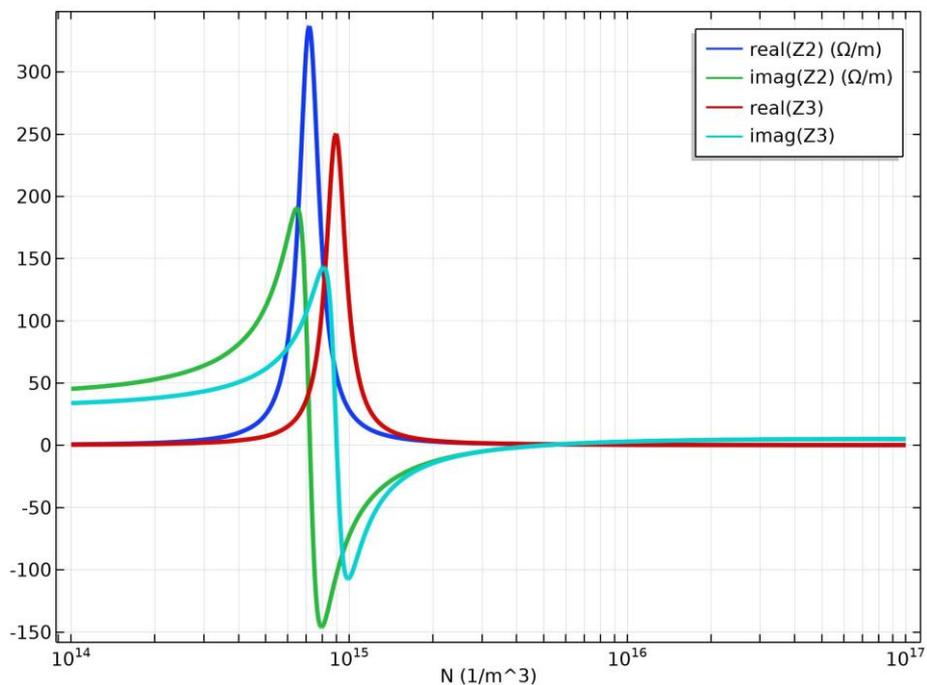


Рис. 5. Пример расчета импеданса разряда как функции плотности электронов.  $Z_2$  – импеданс на границе электрода в плоскости  $z=L$ ,  $Z_3$  – импеданс в точке подвода ВЧ поля к линии передачи. Геометрия разряда соответствует распределению поля ниже.

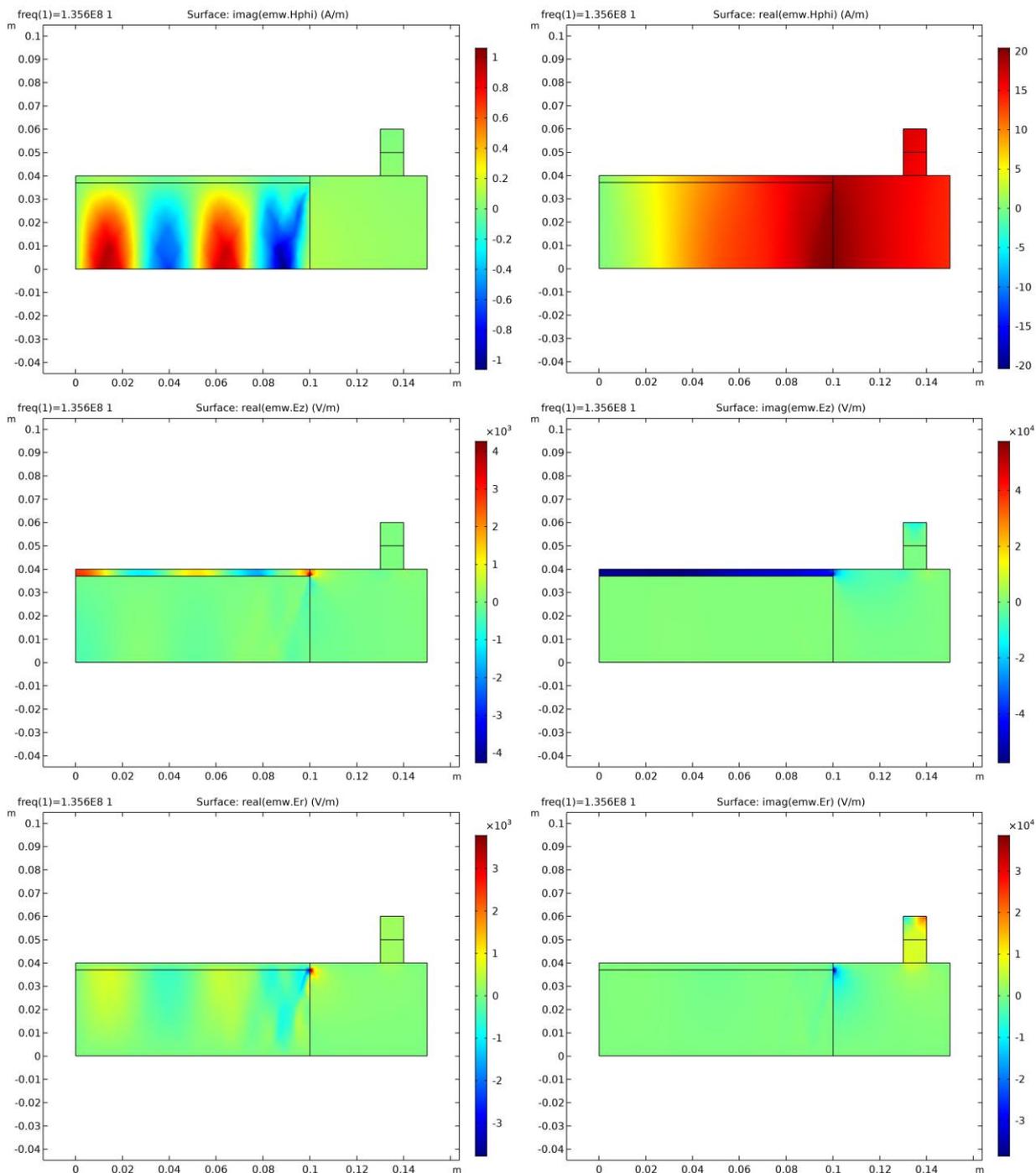


Рис. 6. Пример расчета пространственного распределения электромагнитного поля ВЧ волны в разрядной камере, частота волны 137.6 МГц. Плотность электронов  $2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ , циклотронная частота 500 МГц, постоянное магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$ , отношение частоты столкновений электронов к частоте поля – 0.1.

Расчет показывает, что при синфазном возбуждении зависимость кривых импеданса разряда от плотности электронов напоминает соответствующие кривые в разряде без магнитного поля, есть области емкостного и индуктивного импеданса, что связано с тем, что ток протекает через слои пространственного заряда с емкостным импедансом, а также через плазму, причем ток течет вдоль магнитного поля. При этом полный ток в плазме направлен в сторону противоположную току в слоях, так как  $\epsilon_{zz}$  отрицательно. Поэтому падение напряжение на плазме имеет обратный знак по сравнению с напряжением на слое.

В зависимости от того, какое напряжение больше, разряд в целом имеет индуктивный  $\text{Re}Z < 0$  или емкостной  $\text{Re}Z > 0$  импеданс/

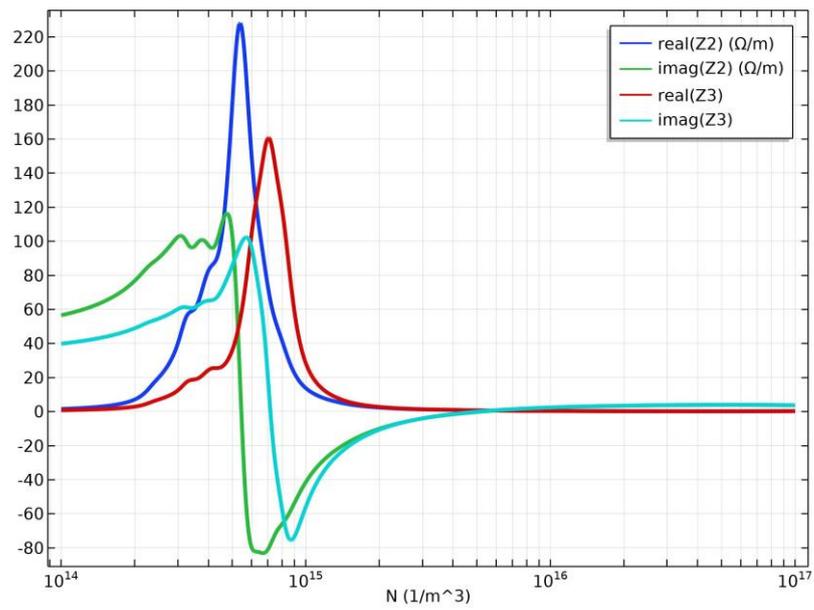
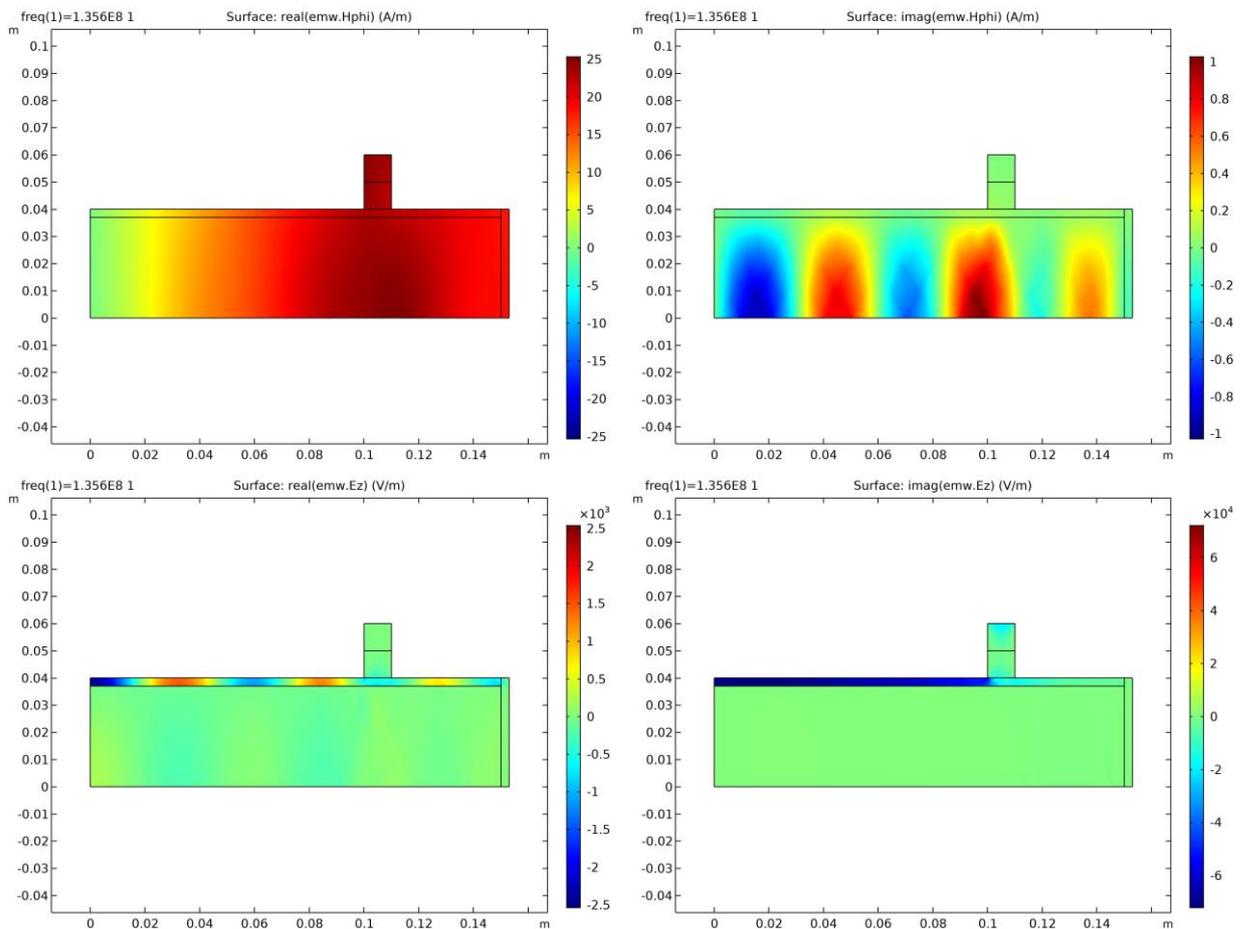


Рис. 7. Пример расчета импеданса разряда как функции плотности электронов.  $Z2$  – импеданс на границе электрода в плоскости  $z=L$ ,  $Z3$  – импеданс в точке подвода ВЧ поля к линии передачи. Геометрия разряда соответствует распределению поля ниже.



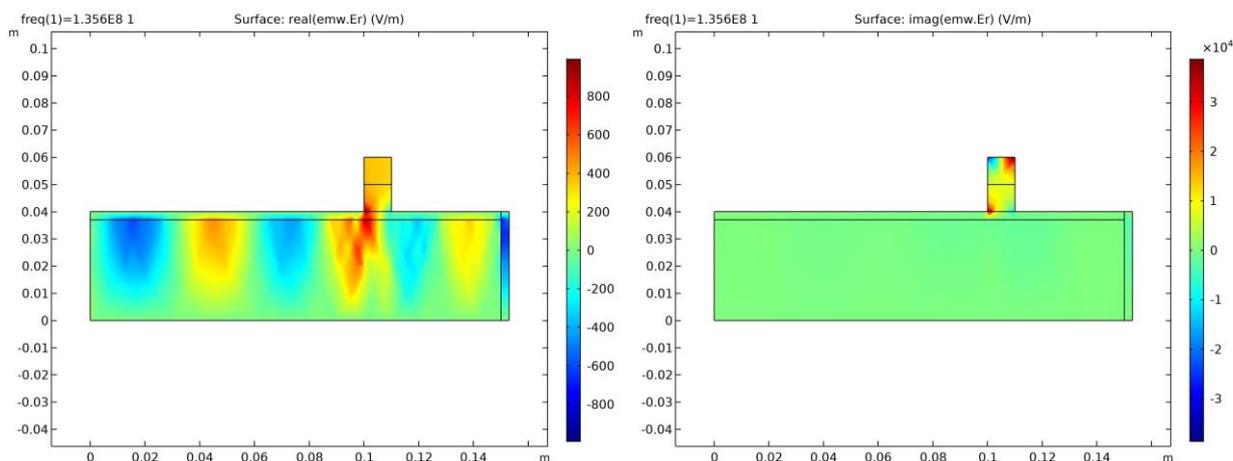


Рис. 8. Пример расчета пространственного распределения электромагнитного поля ВЧ волны в разрядной камере, частота волны 137.6 МГц. Плотность электронов  $2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ , циклотронная частота 500 МГц, постоянное магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$ , отношение частоты столкновений электронов к частоте поля – 0.1.

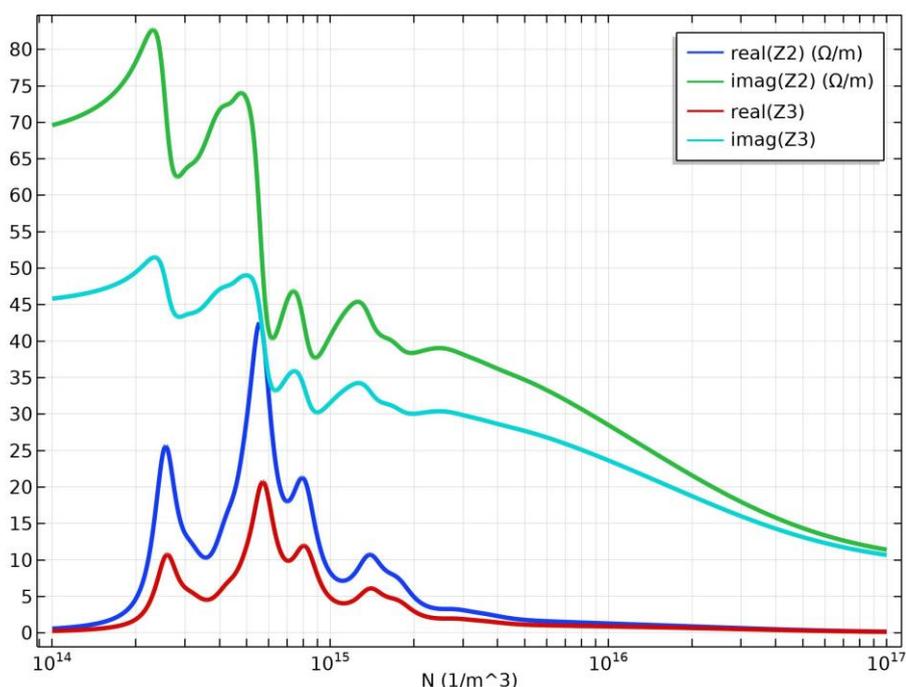


Рис. 9. Пример расчета импеданса разряда как функции плотности электронов.  $Z_2$  – импеданс на границе электрода в плоскости  $z=L$ ,  $Z_3$  – импеданс в точке подвода ВЧ поля к линии передачи. Геометрия разряда соответствует распределению поля ниже.

При антисимметричном возбуждении ток течет поперек магнитного поля. При выбранных расчетных параметрах «эффективная» диэлектрическая проницаемость оказывается больше нуля, поэтому направления токов в плазме и в слоях пространственного заряда совпадают, и импеданс плазмы во всех случаях остается емкостным.

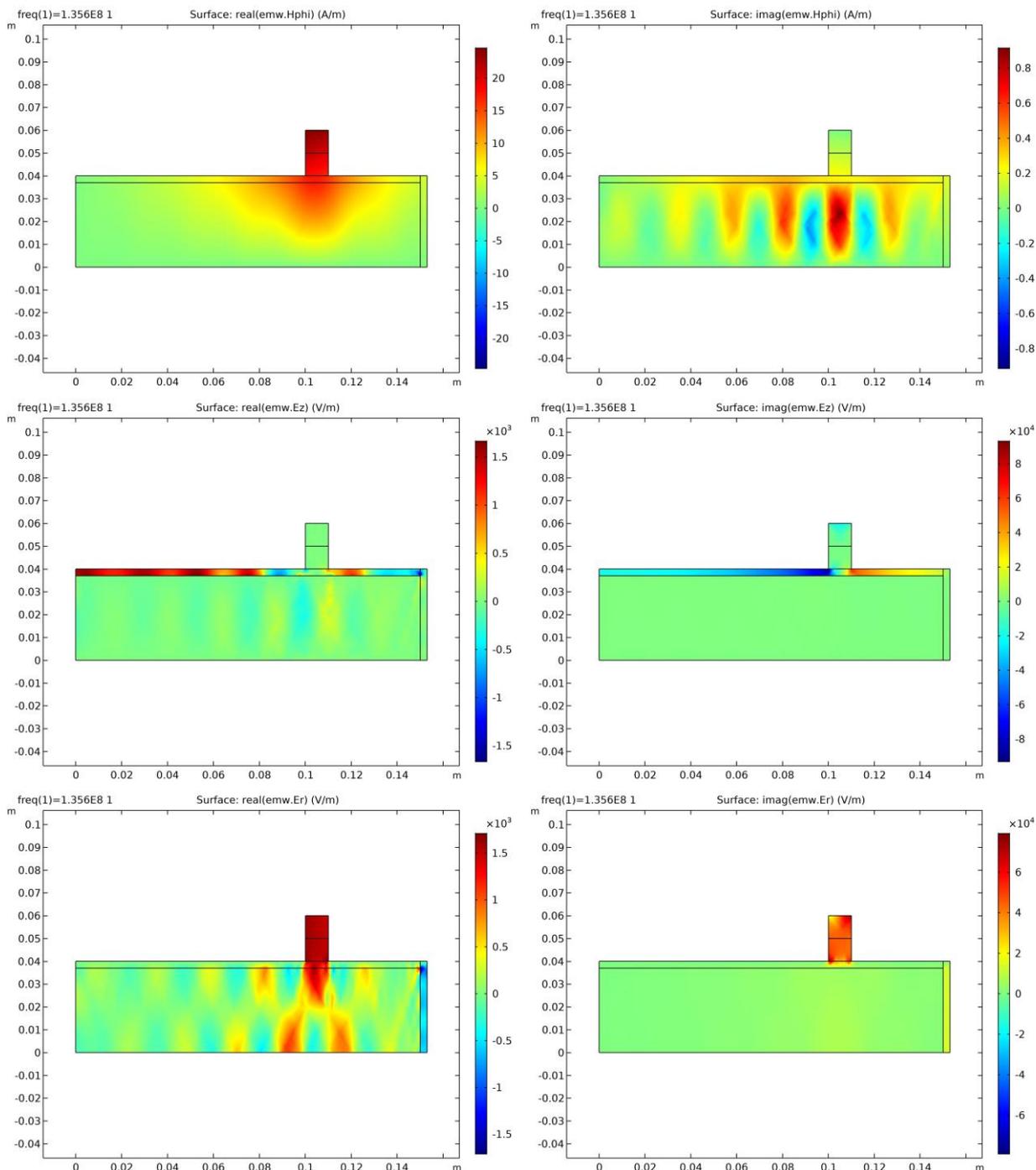


Рис. 10. Пример расчета пространственного распределения электромагнитного поля ВЧ волны в разрядной камере, частота волны 137.6 МГц. Плотность электронов  $2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ , циклотронная частота 500 МГц, постоянное магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$ , отношение частоты столкновений электронов к частоте поля – 0.1. Антисимметричное возбуждение поля.

Расчеты показывают также, что ход кривых импеданса от плотности электронов имеет немонотонный характер, поэтому можно предположить, что в плазме возбуждаются также стоячие электромагнитные волны с длиной, сравнимой с размерами системы. Это предположение подтверждается расчетами структуры поля в разряде (рис. 6, 8, 10)

## 5. Выводы

В данной работе рассмотрена задача о расчете пространственных распределений электромагнитного поля в магнитоактивной плазме. Это задача весьма актуальна в данный момент в связи с необходимостью развития плазменных технологий. В результате выполнения работы

1. Выписаны уравнения определяющие пространственное распределение для электромагнитного поля в магнитоактивной плазме.
2. Проведен расчет дисперсионных кривых волн в магнитоактивной плазме при различных условиях.
3. Проведен расчет возможных неоднородных в пространстве распределений электромагнитного поля.
4. Проведен предварительный расчет импеданса разряда и пространственного распределения электромагнитного поля для модельной геометрии.

Проведенные расчеты могут быть основой для анализа в дальнейшем вольтамперных характеристик и пространственных распределений поля в различных типах разряда в магнитном поле.

## Благодарности

Автор благодарен своему научному руководителю за предложенную интересную тему, позволившую познакомиться с основами электродинамики вообще и электродинамики плазмы в частности. Автор также благодарен руководителю за возможность познакомиться с основами работы в Matlab и COMSOL Multiphysics®.

Автор также благодарен тем членам комиссии по приему дипломных работ, которые прочитали его работу и посмотрели презентацию.

## Приложение I. Расчет векторных полей по их вихрю и дивергенции.

В соответствии с общими теоремами любое векторное поле есть сумма потенциального и вихревого полей  $\mathbf{V} = [\nabla \times \Psi] + (\nabla \psi) = i[\mathbf{k} \times \Psi] + i\mathbf{k}\psi$ . Для того, чтобы найти эти компоненты поля, нужно знать его вихрь и дивергенцию. Если известно, что  $[\nabla \times \mathbf{V}] = \mathbf{\Omega}$ , и  $(\nabla \cdot \mathbf{V}) = i\omega \delta n_e / n_0$ , то:

$$\nabla^2 \Psi = -\mathbf{\Omega}, \quad \nabla^2 \psi = i\omega \delta n_e / n_0$$

При записи уравнений мы ввели соотношение  $(\nabla \cdot \Psi) = 0$ . Аналогичное условие накладывается на вектор-потенциал электромагнитного поля  $\mathbf{A}$  в электродинамике [20]. Введем новые переменные  $\mathbf{\Omega} = [i\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}]$ ,  $\delta n_e = n_0 (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}) / \omega$  и получим для них нужные уравнения

$$\Psi = -\frac{\mathbf{\Omega}}{k^2}, \quad \psi = -\frac{i\omega \delta n_e}{k^2 n_0}$$

Из этих уравнений следует

$$\mathbf{V} = [\nabla \times \Psi] + (\nabla \psi) = i \frac{[\mathbf{k} \times \mathbf{\Omega}]}{k^2} + \frac{\omega \mathbf{k} \delta n_e}{k^2 n_0}$$

Запишем это же соотношение в координатах

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= i \frac{[\mathbf{k} \times \boldsymbol{\Omega}]}{k^2} + \frac{\omega \mathbf{k}}{k^2} \frac{\delta n_e}{n_0} = \frac{i}{k^2} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ k_x & k_y & k_z \\ \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \end{bmatrix} + \frac{\omega}{k^2} \frac{\delta n_e}{n_0} \mathbf{k} = \\ &= \mathbf{x}_0 (k_y \Omega_z - k_z \Omega_y) + \mathbf{y}_0 (k_z \Omega_x - k_x \Omega_z) + \mathbf{z}_0 (k_x \Omega_y - k_y \Omega_x) + \frac{\omega}{k^2} \frac{\delta n_e}{n_0} (\mathbf{x}_0 k_x + \mathbf{y}_0 k_y + \mathbf{z}_0 k_z) \end{aligned}$$

## Приложение II. Движение электрона в постоянном магнитном поле и в скрещенных электрическом и магнитном полях

Рассмотрим движение электрона в постоянных электрическом и магнитном полях без учета столкновений. Запишем уравнения движения для электрона

$$\frac{d\mathbf{V}}{dt} = -\frac{e}{m} \mathbf{E}_0 - \frac{e}{mc} [\mathbf{V} \times \mathbf{H}_0], \quad \frac{d\mathbf{R}}{dt} = \mathbf{V}. \quad (\text{П2.1})$$

Будем считать, что магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$ , а электрическое поле имеет две компоненты  $E_x$  и  $E_z$ . В компонентах (П2.1) можно записать как

$$\frac{dV_x}{dt} = -\frac{e}{m} E_x - \frac{e}{mc} V_y H_0, \quad \frac{dV_y}{dt} = \frac{e}{mc} V_x H_0, \quad \frac{dV_z}{dt} = -\frac{e}{m} E_z \quad (\text{П2.2})$$

Дифференциальные уравнения нужно дополнить начальными условиями

$$\mathbf{V}(0) = (V_{x0}, V_{y0}, V_{z0}), \quad \mathbf{R}(0) = (R_{x0}, R_{y0}, R_{z0}).$$

Третье уравнение решается очень просто

$$V_z = V_0 - \frac{e}{m} E_z t, \quad Z(t) = V_{0z} t - \frac{e}{2m} E_z t^2.$$

Для того, чтобы решить первые два уравнения, продифференцируем второе уравнение по  $t$  и подставим в первое

$$\frac{dV_x}{dt} = -\frac{e}{m} E_x - \frac{e}{mc} V_y H_0, \quad \frac{d^2 V_y}{dt^2} + \left( \frac{e H_0}{mc} \right)^2 V_y = \left( \frac{e H_0}{mc} \right) \frac{e}{m} E_x. \quad (\text{П2.3})$$

Мы получили линейное уравнение. Общее решение линейного уравнения есть сумма частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения. Частное решение неоднородного уравнения в данном случае есть очень простое – движение с постоянной скоростью:

$$V_y = \frac{e}{m} E_x \left/ \left( \frac{e H_0}{mc} \right) \right.$$

Общее решение однородного уравнения

$$\frac{d^2 V_y}{dt^2} + \left( \frac{e H_0}{mc} \right)^2 V_y = 0, \quad V_y = V_S \sin \left( \frac{e H_0}{mc} t \right) + V_C \cos \left( \frac{e H_0}{mc} t \right),$$

Далее мы для простоты введем обозначение  $\Omega_0 = e H_0 / mc$  Таким образом

$$V_y = \frac{e E_x}{m \Omega_0} + V_S \sin(\Omega_0 t) + V_C \cos(\Omega_0 t), \quad V_x = \frac{1}{\Omega_0} \frac{dV_y}{dt} = V_S \cos(\Omega_0 t) - V_C \sin(\Omega_0 t)$$

Учитывая начальные условия, получим

$$V_y = \frac{eE_x}{m\Omega_0} + V_{x0} \sin(\Omega_0 t) + \left( V_{y0} - \frac{eE_x}{m\Omega_0} \right) \cos(\Omega_0 t),$$

$$V_x = \frac{1}{\Omega_0} \frac{dV_y}{dt} = V_S \cos(\Omega_0 t) - \left( V_{y0} - \frac{eE_x}{m\Omega_0} \right) \sin(\Omega_0 t)$$

Таким образом в скрещенных магнитном и электрическом полях электрон движется с постоянной скоростью в направлении, перпендикулярном электрическому и магнитному полям и вращается в плоскости, перпендикулярной постоянному магнитному поля, с циклотронной частотой.

### Приложение III. Детали расчета токов в плазме и диэлектрической проницаемости с учетом давления электронного газа

Для решения уравнений (4) запишем их в компонентах

$$\begin{aligned} -i\omega \mathbf{V}_x &= -iC_S^2 \frac{k_x (k_x \mathbf{V}_x + k_y \mathbf{V}_y + k_z \mathbf{V}_z)}{\omega} - \frac{e}{m} \mathbf{E}_x - \frac{e}{mc} \mathbf{V}_y \mathbf{B} - \nu_{en} \mathbf{V}_x, \\ -i\omega \mathbf{V}_y &= -iC_S^2 \frac{k_y (k_x \mathbf{V}_x + k_y \mathbf{V}_y + k_z \mathbf{V}_z)}{\omega} - \frac{e}{m} \mathbf{E}_y + \frac{1}{c} \frac{e\mathbf{B}}{m} \mathbf{V}_x - \nu_{en} \mathbf{V}_y, \\ -i\omega \mathbf{V}_z &= -iC_S^2 \frac{k_z (k_x \mathbf{V}_x + k_y \mathbf{V}_y + k_z \mathbf{V}_z)}{\omega} - \frac{e}{m} \mathbf{E}_z - \nu_{en} \mathbf{V}_z, \end{aligned}$$

Теперь

$$\begin{aligned} \left( -i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_x k_x}{\omega} \right) \mathbf{V}_x + \left( iC_S^2 \frac{k_x k_y}{\omega} + \frac{e\mathbf{B}}{mc} \right) \mathbf{V}_y - iC_S^2 \frac{k_x k_z}{\omega} \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_x, \\ \left( -\frac{1}{c} \frac{e\mathbf{B}}{m} + iC_S^2 \frac{k_y k_x}{\omega} \right) \mathbf{V}_x - \left( i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_y k_y}{\omega} \right) \mathbf{V}_y + iC_S^2 \frac{k_y k_z}{\omega} \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_y, \\ iC_S^2 \frac{k_z k_x}{\omega} \mathbf{V}_x + iC_S^2 \frac{k_z k_y}{\omega} \mathbf{V}_y + \left( -i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_z k_z}{\omega} \right) \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_z, \end{aligned}$$

Далее для сокращения записи будем использовать циклотронную частоту вместо  $\Omega_0 = e\mathbf{B}/mc$

$$\begin{aligned} \left( -i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_x k_x}{\omega} \right) \mathbf{V}_x + \left( iC_S^2 \frac{k_x k_y}{\omega} + \Omega_0 \right) \mathbf{V}_y - iC_S^2 \frac{k_x k_z}{\omega} \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_x, \\ \left( -\Omega_0 + iC_S^2 \frac{k_y k_x}{\omega} \right) \mathbf{V}_x - \left( i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_y k_y}{\omega} \right) \mathbf{V}_y + iC_S^2 \frac{k_y k_z}{\omega} \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_y, \\ iC_S^2 \frac{k_z k_x}{\omega} \mathbf{V}_x + iC_S^2 \frac{k_z k_y}{\omega} \mathbf{V}_y + \left( -i\omega + \nu_{en} + iC_S^2 \frac{k_z k_z}{\omega} \right) \mathbf{V}_z &= -\frac{e}{m} \mathbf{E}_z, \end{aligned}$$

### Приложение IV. Расчет дисперсии волн в магнитном поле

Исходим из уравнения (9).

$$i\omega \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \left( (-i\omega + \nu_{en}) \mathbf{V}_e + i\mathbf{k} C_S^2 \frac{(\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e)}{\omega} + [\mathbf{V}_e \times \Omega_0] \right) - \omega_{pe}^2 \left( \mathbf{V}_e - \frac{c^2 \mathbf{k}}{\omega^2} (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) \right) = 0$$

Для решения уравнения умножим, как и в случае уравнения для электрического поля, наше уравнение скалярно на  $\mathbf{k}$ .

$$\left( (\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) + i\omega (\mathbf{k} [\mathbf{V}_e \times \boldsymbol{\Omega}_0]) \right) = 0$$

Мы можем использовать циклическую перестановку  $(\mathbf{k} [\mathbf{V}_e \times \boldsymbol{\Omega}_0]) = (\boldsymbol{\Omega}_0 [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e]) = (\mathbf{V}_e [\boldsymbol{\Omega}_0 \times \mathbf{k}])$ . Нам удобно использовать второе соотношение вместо первого

$$\left( (\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) + i\omega (\boldsymbol{\Omega}_0 [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e]) \right) = 0 \quad (\text{П4.1})$$

Таким образом, мы видим, что продольный ток и поперечный ток связаны друг с другом. Однако связь есть не непосредственно с поперечными колебаниями, а с их компонентой, вихрь которой направлен вдоль магнитного поля. Используем третью формулу

$$\left( (\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) + i\omega (\mathbf{V}_e [\boldsymbol{\Omega}_0 \times \mathbf{k}]) \right) = 0$$

Далее мы можем умножить наше исходное уравнение векторно на  $\mathbf{k}$ :

$$i\omega \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \left\{ (-i\omega + v_{en}) [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] + [\mathbf{k} \times [\mathbf{V}_e \times \boldsymbol{\Omega}_0]] \right\} - \omega_{pe}^2 [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] = 0$$

Здесь тоже нужно применить формулу  $[\mathbf{a} \times [\mathbf{b} \times \mathbf{c}]] = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$

$$i\omega \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \left\{ (-i\omega + v_{en}) [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] + \mathbf{V}_e (\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\Omega}_0) - \boldsymbol{\Omega}_0 (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) \right\} - \omega_{pe}^2 [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] = 0$$

Таким образом мы получаем еще одно уравнение, связывающее продольную и поперечную компоненты скоростей

$$i\omega \left( 1 - \frac{c^2 \mathbf{k}^2}{\omega^2} \right) \left\{ (-i\omega + v_{en}) [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] + (\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\Omega}_0) \frac{[\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e]]}{\mathbf{k}^2} - \left( \boldsymbol{\Omega}_0 - \frac{\mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\Omega}_0)}{\mathbf{k}^2} \right) (\mathbf{k} \cdot \mathbf{V}_e) \right\} - \omega_{pe}^2 [\mathbf{k} \times \mathbf{V}_e] = 0$$

Наконец получаем итоговое выражение:

$$\left\{ (-i\omega + v_{en}) + \frac{i\omega \omega_{pe}^2}{(\omega^2 - c^2 \mathbf{k}^2)} \right\} \boldsymbol{\Omega}_0 + (\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\Omega}_0) \frac{[\mathbf{k} \times \boldsymbol{\Omega}_0]}{\mathbf{k}^2} + \left( \boldsymbol{\Omega}_0 - \frac{\mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\Omega}_0)}{\mathbf{k}^2} \right) \frac{i\omega (\boldsymbol{\Omega}_0 \cdot \boldsymbol{\Omega}_0)}{(\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2)} = 0 \quad (\text{П4.2})$$

Будем считать, что магнитное поле направлено вдоль оси  $OZ$ , а волновой вектор имеет все три компоненты  $\mathbf{k} = (k_x, 0, k_z)$ . Дисперсионное уравнение имеет вид

$$\left\{ \left\{ (\omega + iv_{en}) - \frac{\omega \omega_{pe}^2}{(\omega^2 - c^2 \mathbf{k}^2)} \right\} - \frac{k_x^2}{\mathbf{k}^2} \frac{\omega \boldsymbol{\Omega}_0^2}{(\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2)} \right\} \left\{ (\omega + iv_{en}) - \frac{\omega \omega_{pe}^2}{(\omega^2 - c^2 \mathbf{k}^2)} \right\} - \frac{k_z^2 \boldsymbol{\Omega}_0^2}{\mathbf{k}^2} = 0$$

Если положить  $\mathbf{k} = (k \sin \theta, 0, k \cos \theta)$ , получим

$$\left\{ \left\{ (\omega + iv_{en}) - \frac{\omega \omega_{pe}^2}{(\omega^2 - c^2 \mathbf{k}^2)} \right\} - \frac{\omega \boldsymbol{\Omega}_0^2 \sin^2 \theta}{(\omega(\omega + iv_{en}) - \mathbf{k}^2 C_s^2 - \omega_{pe}^2)} \right\} \left\{ (\omega + iv_{en}) - \frac{\omega \omega_{pe}^2}{(\omega^2 - c^2 \mathbf{k}^2)} \right\} + \boldsymbol{\Omega}_0^2 \cos^2 \theta = 0$$

## Список литературы

- 1 Кралькина Е.А. УФН, 178 519 (2008).
- 2 Thomson J.J. *Philos. Mag.* **32** 321 (1891).
- 3 Hittorf W. *Ann. Phys. Chem.* **21** 90 (1884).
- 4 Townsend J. S., Donaldson R. H. *Philos. Mag.* **5** 178 (1928).
- 5 Townsend J. S., Donaldson R. H. *Philos. Mag.* **7** 600 (1929).
- 6 MacKinnon K. A. *Philos. Mag.* **8** 605 (1929).
- 7 Hopwood J. *Plasma Sources Sci. Technol.* **1** 109 (1992).
- 8 Loeb H. W. "Recent work on radio frequency ion thrusters" *J. Spacecraft Rockets* **8** 494 (1971).
- 9 Godyak V. A., Alexandrovich B M, Piejak R B, US Patent 5,834,905 (November 19, 1998).
- 10 Stevens J. E. "Electron cyclotron resonance plasma sources", in *High Density Plasma Sources' Design, Physics, and Phenomena* (Ed. O A Popov) (Park Ridge, NJ Noyes Publ., 1995) p. 312
- 11 Boswell R. W., US Patent 4,810,935 (March 7, 1989).
- 12 Chen F. F., "Helicon plasma sources", in *High Density Plasma Sources' Design, Physics, and Phenomena* (Ed. O A Popov) (Park Ridge, NJ Noyes Publ., 1995) p. 1.
- 13 Александров А.Ф. и др. *ЖТФ* **64** (11) 53 (1994) [Aleksandrov A F et al. *Tech Phys.* **39** 1118 (1994)].
- 14 Александров А.Ф. и др., Патент РФ 2095877.
- 15 Силин В. П., Рухадзе А. А. *Электромагнитные свойства плазмы и плазмopodobных сред* (М.: Госатомиздат, 1961).
- 16 Гинзбург В. Л., Рухадзе А. А. *Волны в магнитоактивной плазме* (М.: Наука, 1970).
- 17 Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А. А. *Основы электродинамики плазмы* (М.: Высшая школа, 1978) [Translated into English: Aleksandrov A. F., Bogdankevich L. S., Rukhadze A. A. *Principles of Plasma Electrodynamics* (Berlin' SpringerVerlag, 1984)].
- 18 Ахиезер А.И. и др. *Электродинамика плазмы*. М. Наука 1974.
- 19 Sazontov V.A., Semenov V.E., and Smirnov A. I. // *Plasma Physics Reports*, 2007, Vol. 33, No. 11, pp. 961–968.
20. Борн М.. Вольф Э. *Основы оптики*. М.: Наука 1973.